

超低待机功耗准谐振交直流转换芯片

概述

PN8160内部集成了脉宽调制控制器和功率MOSFET，专用于高性能、外围元器件精简的交直流转换开关电源。该芯片提供了极为全面和性能优异的智能保护功能，包括周期式过流保护、过载保护、软启动功能。通过QR+CCM、Eco-mode、Burst-mode的三种模式混合调制技术和特殊器件低功耗结构技术实现了超低的待机功耗、全电压范围内的最佳效率。频率调制技术和SoftDriver技术充分保证良好的EMI表现。PN8160为需要超低待机功耗的高性价比反激式开关电源系统提供了一个先进的实现平台，非常适合六级能效Level6、Eur2.0、能源之星的应用。

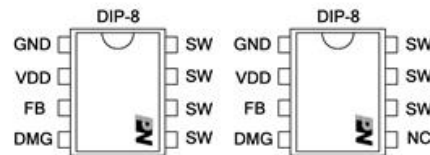
特征

- 内置650V高雪崩能力的功率MOSFET
- 兼具连续导通（CCM）和QR模式的多模式转换器
- Eco-mode（动态PFM）
- Burst-mode（25kHz间歇工作模式）
- 改善EMI的频率调制技术
- 空载待机功耗 < 50 mW @230VAC
- 软启动技术
- 内置高压启动电路
- 内置线电压补偿和斜坡补偿
- 优异全面的保护功能
 - ◇ 过温保护（OTP）
 - ◇ VDD的欠压及过压保护
 - ◇ 逐周期过流保护（OCP）
 - ◇ 输出开/短路保护
 - ◇ 专利的DMG电阻开/短路保护(Latch模式)
 - ◇ 次级整流管短路保护
 - ◇ 过载保护（OLP）

应用领域

- 待机电源
- 机顶盒等外置电源

封装/订购信息



订购代码	封装	典型功率
		90~265V _{AC}
PN8160NEC-T1H	DIP8	24W
PN8160NEC-T1M	DIP8	18W

注：最大输出功率是在环境温度 40℃ 的密闭式应用情形下测试。

典型应用

